分子動力学法を用いた静水圧荷重下における多層カーボンナノチューブの座屈挙動解析

北海道大学大学院工学院	学生会員	○草野	彩子
北海道大学大学院工学院	学生会員	石渡	裕太
北海道大学大学院工学研究院	正会員	佐藤	太裕

1. まえがき

カーボンナノチューブ (Carbon Nanotube, 以下 CNT)は、炭素原子の六員環が連なり形成されたグラフ エンシートを円筒状に丸めた中空形状の物質であり、 単層や二層、多層が存在する. CNT の特徴は、優れた 強度、しなやかな弾性力といった力学的特性、そして 高熱伝導特性や特異な電気的性質を保持している点で ある.現在、CNT はスポーツ製品や携帯電話の電子材 料等で活躍している.更に将来は、航空宇宙や各種工 学分野での材料物質としての利用が期待されている.

従来の主な構造解析手法の一つである円筒シェル理 論では、一層ごとに連続体に近似し解析を行ってい た.¹⁾この手法は簡便であり、変形が小さい領域では精 度上問題はないが、大変形を伴う挙動や断面変形によ る電気的性質の変化等を正確に検証することは不可能 である.本研究では、原子一つ一つの運動を追跡する ことでより厳密な挙動解析を可能とする分子動力学法 (Molecular Dynamics、以下 MD 法)¹⁾を用い、静水圧荷 重下での CNT の座屈挙動を原子レベルで検証すること を試みた.

2. 解析モデル

2.1 外圧作用時の多層 CNT の変形挙動

図-1 は解析対象とする 4 層の CNT の断面図,図-2 は その側面図,そして図-3 はその俯瞰図である.対象と する CNT のカイラルベクトル (m,0)は,内側より (m,0)=(6,0)/(12,0)/(18,0)/(24,0)と表され,ジグザグ型の 構造である.また全ての解析において CNT に z 軸方向 にのみ周期境界条件を適用し,平面ひずみ状態を仮定 した.本解析では対象とした 4 層 CNT に外圧が作用し た際の座屈挙動を原子レベルで検証する.

2.2 MD 法と円筒シェル理論の定量的比較

各々のカイラルベクトル(*m*,0)=(24,0), (36,0), (48,0), (54,0) である4種類の単層CNTについて解析を行った. 本解析では, MD 法と円筒シェル理論における座屈荷 重を比較,そして層厚について検証した.

2.3 単層 CNT における大変形解析

カイラルベクトル(*m*,0)=(36,0)の単層 CNT について解 析を行った.本解析では MD 法により座屈後の大変形 の追跡が可能であるか検証した.

3. 定式化

MD 法とは原子シミュレーションの一つ, 原子の運動(位置, 速度データ)を追跡することで物質の特性 を評価する方法である. MD 法では物質系ではなく, ニュートン力学に従う質点系として原子を取り扱う.



図-1 解析モデル CNT 断面図





$$\frac{d^2 r_i}{dt^2} = \frac{F_i}{m_i}$$
(1)
 $i = 1, 2..., N$

$$r_{i}(t + \Delta t) = 2r_{i}(t) - r_{i}(t - \Delta t) + (\Delta t)^{2} \frac{F_{i}(t)}{m_{i}}$$
(2)

$$v_{i}(t) = \frac{1}{2\Delta t} \{ r_{i}(t + \Delta t) - r_{i}(t - \Delta t) \}$$
(3)

他の原子から力を受けながら,運動する N 個の原子 其々に (1) 式で表される運動方程式を設定する. 三次 元空間では, (1) 式は3N 個の連立2階常微分方程式と なり,時間積分を行う. この時粒子 *i* の位置を *r_i*,速度 を *v_i*とすると, (2), (3) 式のように表される. この(2), (3) 式を利用して,粒子の位置と速度を求める.

次に原子間ポテンシャルについて考える. 現実の原 子で発生しているポテンシャルを厳密に求める為には, 集合体に適したポテンシャル関数を採用する事が重要 である. 今回は CNT の変形を検証する際に一般的に使 われる Brenner の原子間ポテンシャル関数²⁾を用いた. Brenner の原子間ポテンシャル関数において,ポテンシ ャルは経験的な結合次数のモデルに基づいており,ポ テンシャルエネルギー E_b は, (4) 式の様に表される.

$$E_b = \sum_i \sum_{j < i} [V_R(r_{ij}) - \overline{B_{ij}} V_A(r_{ij})]$$
(4)

ここで r_{ij} は原子 i と原子 j の距離, V_R は斥力関数, V_A は引力関数であり, (5), (6) 式の様に表される.

$$V_{R} = f(r)\frac{D}{S-1}\exp[-\beta\sqrt{2S}(r-R)]$$
(5)

$$V_A = f(r) \frac{DS}{S-1} \exp[-\beta \sqrt{\frac{2}{S}} (r-R)]$$
(6)

キーワード 座屈 分子動力学法 CNT

連絡先 〒060-8628 北海道札幌市北区北 13 条西 8 丁目 北海道大学大学院工学院 TEL011-706-6115

また上式 (5), (6) のパラメータの一つである関数 f (r) は (7) 式のように表される.

$$f(r) = 1 (r < R_1)$$

$$f(r) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(\pi \frac{r - R_1}{R_2 - R_1}) (R_1 < r < R_2) \quad (7)$$

$$f(r) = 0 (r < R_2)$$

ここで B_{ij} は $B_{ij}=0.945$ とする.³⁾ グラフより $V_A(r)$, V_R (r)は単調減少関数となる一方, $V_R - BV_A$ は $r \sim 1.42$ Åで最 小を迎え増加に転ずる関数である. この時のr値, 1.42 Åとは, 平らなグラファイト層での原子間のつり合い 距離の値である. なお(4) - (7)式におけるその他のパ ラメータは,参考文献²⁾より導出した.

4. 解析結果

4.1 外圧作用時の多層 CNT の変形挙動

図-4 は対象とする4層 CNT に外圧が作用していない 時の断面図である.この CNT に外圧を作用させると, 図-5 の様に外層から内層の順番に半径方向に収縮が起 きるが,全ての層が円形を保持している.その後外圧 を作用し続けると,図-6 の座屈状態に至る.この座屈 状態において,外側三層は n=6 の波状変形を示してい るが,最内層は円形を保持している.これは過去に実 施した変形形状と同様の変形形状である.

4.2 MD 法と円筒シェル理論の定量的比較

図-7 はMD法により得られる単層CNTにおける座屈 荷重の変化を示したものである. MD 法においても, 円筒シェル理論により得られる座屈荷重の変化⁴⁾と同 様に変化している. このことから単層 CNT において, 円筒シェル理論により得られる座屈荷重の変化と同様 の変化を, MD 法においても確認することが出来た.ま た MD 法による解析から導出された座屈荷重を用い,円 筒シェル理論に適用し層厚を換算すると,図-8 が得ら れた.半径が大きくなり曲率が小さくなると,層厚は 一定値に収束することが確認された.

4.3 単層 CNT における大変形解析

図-9 は単層 CNT における座屈後の大変形である. 波数 *n*=2 の楕円型に座屈変形を起こした後, CNT 全体が つぶれ, 瓢箪の様な形状が導出される事が確認された.

5. まとめ

本研究から以下の知見が得られた.

・円筒シェル理論に基づく CNT の座屈挙動解析におい て見られる座屈変形が, MD 法を用いた座屈挙動解析 においても,同様の座屈変形が導出された.

・MD 法においても、円筒シェル理論同様の座屈荷重の 変化が導出された.

 ・曲率が小さくなるにつれて、層厚 h が一定値に収束 する傾向を確認できた。

・MD 法を用いた解析により,座屈後の大変形を追跡する事が可能である.



図-4 外圧が作用していない CNT の断面図



図-5 円形を保持した状態で収縮している CNT







図-7 MD 法による座屈荷重の変化



図-8 MD法から換算される層厚hの変化



図-9 単層 CNT における座屈後の大変形

参考文献

1) 上田顯. コンピュータシミュレーション 第三版,

- 朝倉書房, 1992, ISBN 4-254-12069-9 C3041
- 2) D. W. Brenner, Phys. Rev. B 42, (1990) 9458-9471

3) H. Shima, Y. Umeno and M. Sato. Molecular dynamics study of radial corrugation in carbon nanotubes, Mechanics of Advanced Materials and Structures (accepted)

4) H. Shima, M. Sato. Multiple radial corrugations in multiwalled carbon nanotubes under pressure, Nanotechnology 19 (2008) 495705:1-495705:8